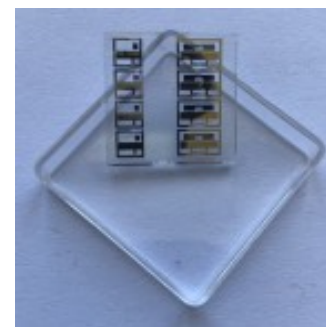


# Stellenausschreibung

## Wissenschaftliche/Studentische Hilfskraft zur Charakterisierung des Rauschverhaltens der IGZO Transistoren

Die Bereiche Sensoren, Biomedizin und Industrieelektronik benötigen Technologien, die Milliarden von Geräte und Menschen miteinander verbinden können. Die bestehenden Siliziumprozesse wären aufgrund ihrer höheren Herstellungskosten ineffizient in diesem Aspekt. Zu diesem Zweck sucht die aktuelle Forschung nach großflächigen Halbleiterbauelementen, die aus Metalloxiden wie Indiumgalliumzinkoxid (IGZO) hergestellt werden können. Für den Entwurf einer Kommunikationsschaltung aus einer beliebigen Technologie benötigen wir zuverlässige Nieder- und Hochfrequenzrauschmodelle der Transistoren.



© IHCT

Am Lehrstuhl für Hochfrequenzsysteme in der Kommunikationstechnik, können Sie unsere in-house hergestellten IGZO-Transistoren charakterisieren und modellieren.

Hier können Sie ihr theoretisches Wissen in der Praxis umsetzen, indem Sie unsere erfahrenen Mitarbeiter/innen bei folgenden Tätigkeiten unterstützen:

- Dicing von IGZO-Chips auf Glas
- Chippackaging durch Wirebonding
- Testbench und coding zur Rauschmessung

### Erforderliche Unterlagen:

Anschreiben, Lebenslauf, aktueller Notenspiegel und Studienbescheinigung, Zeugnisse, Angabe der maximal möglichen Arbeitszeit pro Woche

### Ihr Profil:

Eingeschriebener Student an einer Hochschule, mindestens im zweiten Fachsemester, in einem der folgenden Studiengänge: Elektrotechnik, Informationstechnologie, Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik, Physik oder vergleichbarer Studiengang. Grundlagen im Aufbau von Transistoren (CMOS), Verstärkern und deren Rauschverhalten, Grundkenntnisse in Python/Matlab oder einer anderen Programmiersprache, Erfahrung im PCB Design und gute Englischkenntnisse sind von Vorteil.

**Ansprechpartner:** M.Sc. Utpal Kalita  
**Email:** [kalita@uni-wuppertal.de](mailto:kalita@uni-wuppertal.de)